

## 高效率、低噪声、Multi-Level AGC、二合一第八代 K 类音乐功放

### 特性

- ◆ Multi-Level AGC 算法，有效消除杂音，纯净音质
- ◆ 低噪声：43 $\mu$ V
- ◆ 超低失真度：0.008%
- ◆ 整体效率高达 83%
- ◆ 支持 Speaker, Receiver 二合一应用
  - ◆ Receiver: 1V/V, Vn=19 $\mu$ V, THD+N=0.025%
  - ◆ Receiver: 3V/V, Vn=22 $\mu$ V, THD+N=0.025%
- ◆ 喇叭保护功率可配：0.6W、0.7W、0.8W、0.9W、1W、1.1W 和 1.2W
- ◆ 锂电池电压范围内，保持恒定大音量
- ◆ 支持 6 欧姆喇叭
- ◆ 兼容 AW8736, AW8737, AW87317
- ◆ 超强 TDD-Noise 抑制
- ◆ 优异的 pop-click 抑制
- ◆ 一线脉冲控制
- ◆ 高 PSRR: -68dB (217Hz)
- ◆ ESD 保护:  $\pm$ 6kV (HBM)
- ◆ 纤小的 0.4mm pitch 1.6mm $\times$ 1.68mm CSP-14 封装

### 应用

- ◆ 智能手机

### 概要

AW87318 是专门针对消除智能机音乐杂音，提升整体音质而开发的高效率，低噪声，恒定大音量的升级版第八代 K 类音乐功放。AW87318 集成艾为专有的 Multi-Level AGC 算法，有效消除音乐播放中的杂音，同时提升音质音量。AW87318 采用效率高达 93% 的 K-Chargepump 电荷泵升压技术，使功放整体效率高达 83%；AW87318 的底噪低至 43 $\mu$ V，具有高达 98.8dB 的信噪比(SNR)，0.008% 的超低失真度和独特的 Multi-Level AGC 技术，带来高品质的音乐享受。

AW87318 有 0.6W~1.2W 七个细分喇叭保护功率等级，适合不同额定功率的喇叭，应用灵活，同时配合 Multi-Level AGC 算法，使音乐纯粹自然，悦耳动听。AW87318 输出功率在手机整个工作电压（3.3V-4.35V）内保持恒定，防止手机使用过程中，声音越来越小。

AW87318 支持 Speaker 和 Receiver 的二合一应用。在 Receiver 应用时，输出底噪低至 19 $\mu$ V，D 类工作模式，电源由 VBAT 直通提供。

AW87318 内置过流保护、过热保护和短路保护功能，有效地保护芯片。AW87318 采用纤小的 0.4mm pitch 1.6mm $\times$ 1.68mm CSP-14 封装。

### 典型应用图

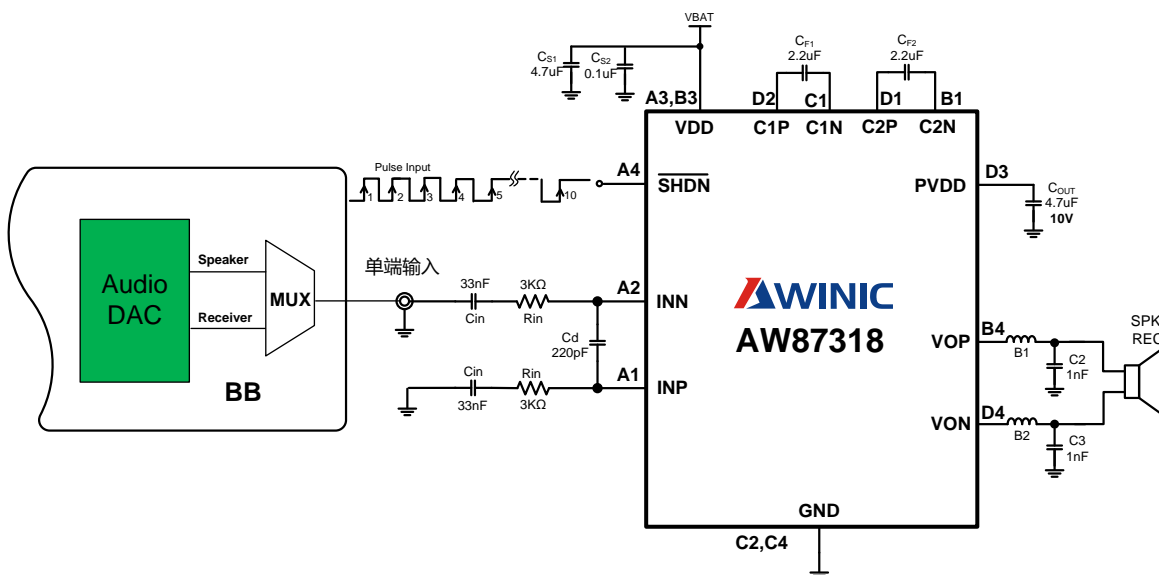


图 1 AW87318 单端输入方式应用图

手册中提到的全部商标所有权归各自拥有者所有。

## 引脚分布及标识图

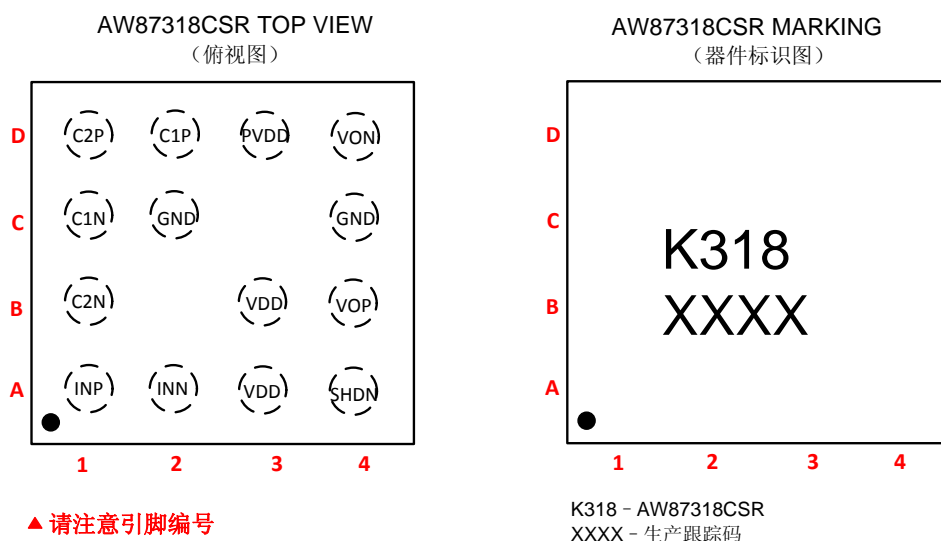


图 2 AW87318 引脚分布俯视图及器件标识图

## 引脚定义及功能

序号	符号	描述
A1	INP	正相输入端
A2	INN	反相输入端
A3	VDD	电源
A4	SHDN	芯片关断引脚, 低有效; 支持一线脉冲控制
B1	C2N	Flying 电容 C2 的负相端
B3	VDD	电源
B4	VOP	正相输出端
C1	C1N	Flying 电容 C1 的负相端
C2, C4	GND	模拟地
D1	C2P	Flying 电容 C2 的正相端
D2	C1P	Flying 电容 C1 的正相端
D3	PVDD	升压电荷泵输出电压
D4	VON	反相输出端

## 艾为同系列产品对比

项目	测试条件	AW8736	AW8737	AW87317	AW8738	AW87318
输出 PVDD(V)	VDD=4.2V	5.8	6.05	6.05	6.05	6.05
输出噪声电压(μV)	VDD=4.2V, f=20Hz to 20kHz, input ac grounded, Av=8V/V, A-weighting	125	52	53	40	43
效率(%)	V <sub>DD</sub> =3.6V, P <sub>o</sub> =1.0W, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH	75	80	80	83	83

功能框图

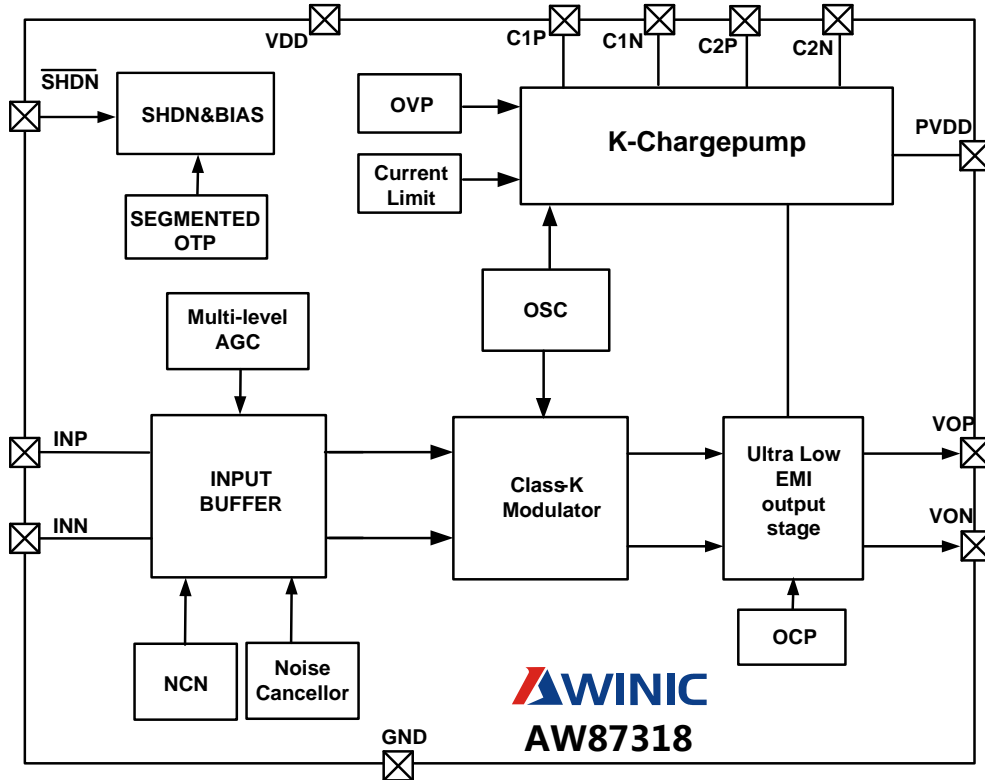


图 3 AW87318 功能框图

典型应用图

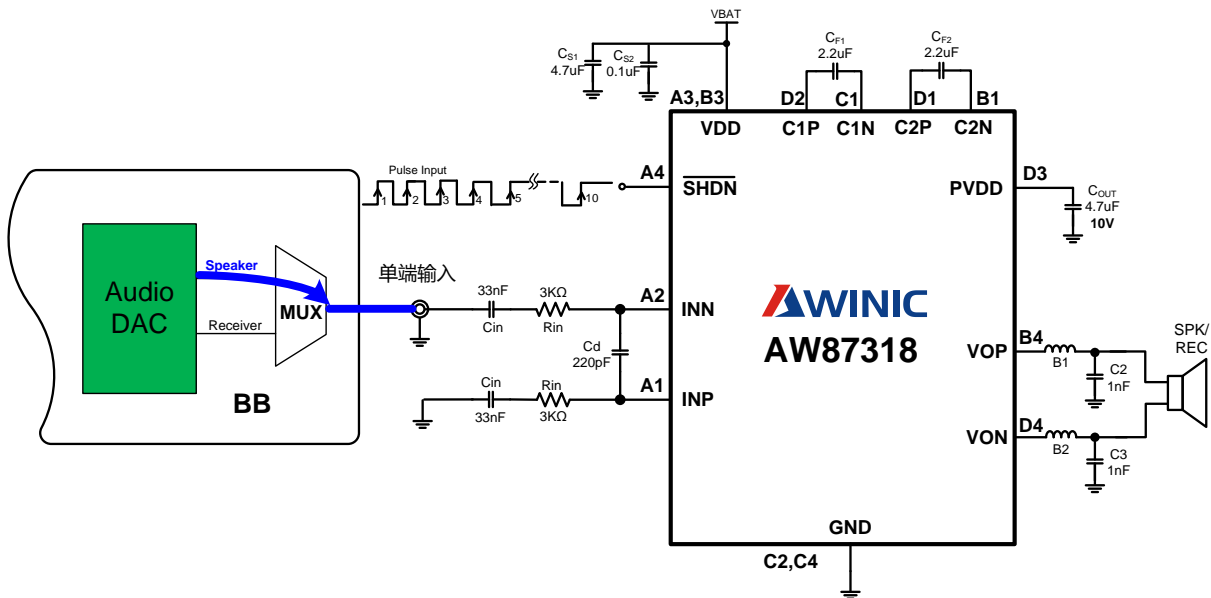


图 4 AW87318 Speaker 模式应用图<sup>(注1)</sup>

注 1: 单端输入时, 可以从 INN、INP 任意一输入端输入音频信号, 另一输入端通过输入电阻、电容接地。AW87318 也可差分输入。

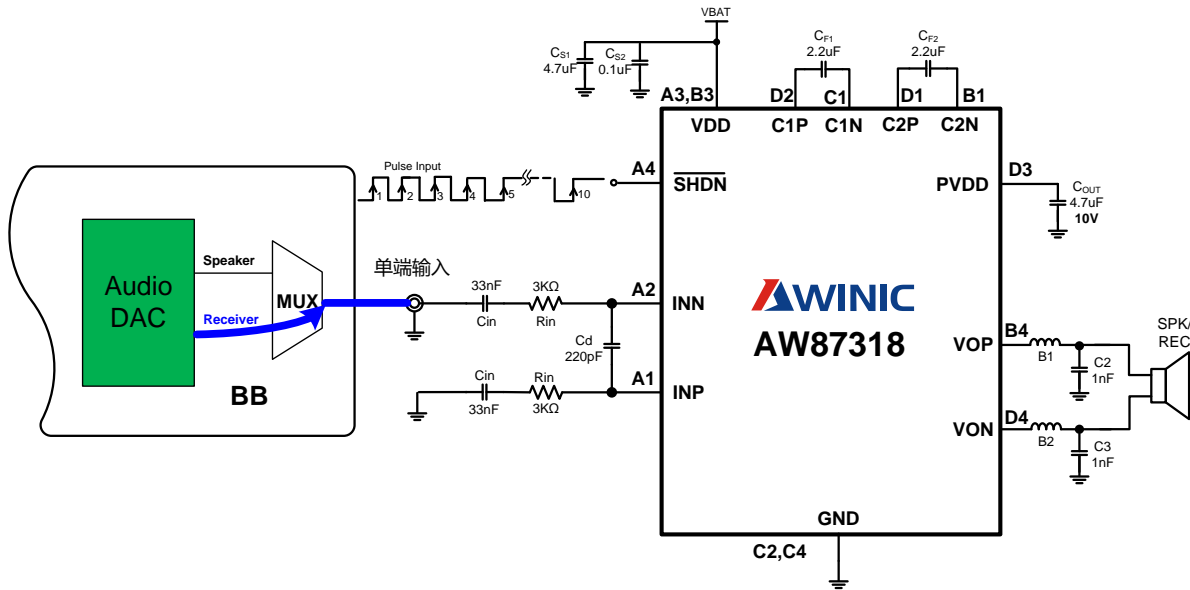
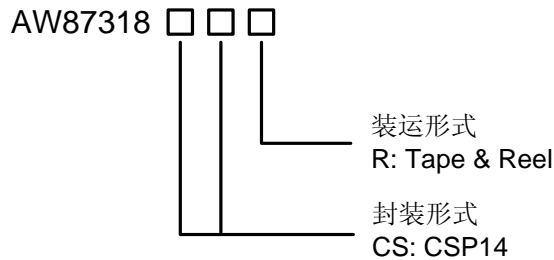


图 5 AW87318 Receiver 模式应用图

### 订购信息

产品型号	工作温度范围	封装形式	器件标记	发货形式
AW87318CSR	-40°C~85°C	CSP-14	K318	卷带包装 3000 片/盘



### 绝对最大额定值<sup>(注2)</sup>

参数	范围
电源电压 $V_{DD}$	-0.3V to 6V
INP, INN 引脚电压	-0.3V to $V_{DD}+0.3V$
封装热阻 $\theta_{JA}$	84.9°C/W
环境温度	-40°C to 85°C
最大结温 $T_{JMAX}$	125°C

存储温度 T <sub>STG</sub>	-65°C to 150°C
引脚温度 (焊接 10 秒)	260°C
ESD 范围 <sup>(注 3)</sup>	
HBM (人体静电模式)	±6KV
Latch-up	
测试标准: JEDEC STANDARD NO.78B DECEMBER 2008	+IT: 450mA -IT: -450mA






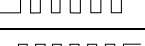
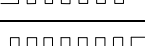

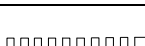
注 2: 如果器件工作条件超过上述各项极限值, 可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极限值, 不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下, 其可靠性及寿命可能受到影响。

注 3: HBM 测试方法是存储在一个 100pF 电容上的电荷通过 1.5 KΩ 电阻对引脚放电。测试标准: MIL-STD-883G Method 3015.7

## 模式说明 (TA=25°C, VDD=4.2V)

AW87318 功放外部输入电容为 C<sub>in</sub>, 外部输入电阻为 R<sub>in</sub>, 内部输入电阻为 6.6KΩ, 放大倍数为 159.5K/(R<sub>in</sub>+6.6K)。推荐的典型应用:

1、C<sub>in</sub>=33nF, R<sub>in</sub>=3KΩ, 放大倍数为 16.6V/V;

模式	使能信号	放大倍数 (V/V)	AGC 功率 (W)				Multi-Level AGC 功能	Receiver 模式
			RL=8Ω +33μH	RL=6Ω +33μH	RL=4Ω +15μH	RL=3Ω +15μH		
模式 1		16.6	1.2	1.6	—	—	√	
模式 2		16.6	1.1	1.5	—	—	√	
模式 3		16.6	1.0	1.3	2.0	—	√	
模式 4		16.6	0.9	1.2	1.8	—	√	
模式 5		16.6	0.8	1.0	1.6	2.0	√	
模式 6		16.6	0.7	0.9	1.4	1.8	√	
模式 7		16.6	0.6	0.8	1.2	1.6	√	
模式 8		1						√
模式 9		3						√
模式 10		16.6	1.75W @ THD=1%	2.05W @ THD=1%	2.4W @ THD=1%	2.35W @ THD=1%		

## 电气特性

测试条件:  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{DD}=3.6\text{V}$ ,  $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$ ,  $f=1\text{kHz}$  (除非特别说明)

参数		条件	最小	典型	最大	单位
$V_{DD}$	电源电压		3.0		5.5	V
$V_{IH}$	SHDN 高电平输入		1.3		$V_{DD}$	V
$V_{IL}$	SHDN 低电平输入		0		0.35	V
$ V_{OS} $	输出失调电压	无输入, $V_{DD}=3.0\text{V to }5.5\text{V}$	-30	0	30	mV
$I_{SD}$	关断电流	$V_{DD}=3.6\text{V}$ , $SHDN=0\text{V}$			1	$\mu\text{A}$
$T_{TG}$	Thermal AGC 启动温度阈值			150		$^{\circ}\text{C}$
$T_{TGR}$	Thermal AGC 退出温度阈值			130		$^{\circ}\text{C}$
$T_{SD}$	过温保护温度阈值			160		$^{\circ}\text{C}$
$T_{SDR}$	过温保护退出温度阈值			120		$^{\circ}\text{C}$
$T_{ON}$	启动时间			40		ms
<b>K-Chargepump 电荷泵</b>						
$PVDD$	输出电压	$V_{DD}=3.0\text{V to }4\text{V}$		1.5* VDD		V
		$V_{DD}>4\text{V}$		6.05		V
$V_{hys}$	OVP 迟滞电压	$V_{DD}>4\text{V}$		50		mV
$F_{CP}$	电荷泵工作频率	$V_{DD}=3.0\text{V to }5.5\text{V}$	0.8	1.06	1.33	MHz
$\eta_{CP}$	电荷泵效率	$V_{DD}=3.6\text{V}$ , $I_{load}=200\text{mA}$		93		%
$T_{ST}$	软启动时间	空载, $C_{OUT}=4.7\mu\text{F}$	1	1.2	1.4	ms
$I_L$	PVDD 短地限流		200	300	400	mA
<b>K 类功放 (模式 1-7, 模式 10)</b>						
$I_q$	静态电流	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , 无输入, 空载		10	15	mA
$\eta$	效率	$V_{DD}=3.6\text{V}$ , $P_o=1.0\text{W}$ , $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$		83		%
		$V_{DD}=3.6\text{V}$ , $P_o=1.0\text{W}$ , $R_L=6\Omega+33\mu\text{H}$		83		%
Fosc	调制频率	$V_{DD}=3.0\text{V to }5.5\text{V}$	600	800	1000	kHz
$A_v$	放大倍数	外部输入电阻=3k $\Omega$		16.6		V/V
$V_{in}$	推荐输入信号幅度	$V_{DD}=3.0\text{V to }5.5\text{V}$			1	Vp
Rini	内部输入电阻	模式 1~模式 7, 模式 10		6.6		k $\Omega$
Fhin	输入高通截止频率	$C_{in}=33\text{nF}$ , 外部输入电阻=3k $\Omega$		502		Hz
P <sub>agc</sub>	模式 1 的 Multi-Level AGC 功率	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$	1.08	1.2	1.32	W
		$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=6\Omega+33\mu\text{H}$	1.44	1.6	1.76	W
		$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=4\Omega+15\mu\text{H}$	2.16	2.4	2.64	W
		$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=3\Omega+15\mu\text{H}$	2.16	2.4	2.64	W
	模式 2 的 Multi-Level AGC 功率	$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=8\Omega+33\mu\text{H}$	0.99	1.1	1.21	W
		$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=6\Omega+33\mu\text{H}$	1.35	1.5	1.65	W
$V_{DD}=4.2\text{V}$ , $R_L=4\Omega+15\mu\text{H}$		1.98	2.2	2.42	W	

参数		条件		最小	典型	最大	单位
Pagc	模式 3 的 Multi-Level AGC 功率	V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH		2.16	2.4	2.64	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH		0.9	1	1.1	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH		1.17	1.3	1.43	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH		1.8	2	2.2	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH		2.16	2.4	2.64	W
	模式 4 的 Multi-Level AGC 功率	V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH		0.81	0.9	0.99	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH		1.08	1.2	1.32	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH		1.62	1.8	1.98	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH		2.16	2.4	2.64	W
	模式 5 的 Multi-Level AGC 功率	V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH		0.72	0.8	0.88	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH		0.9	1	1.1	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH		1.44	1.6	1.76	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH		1.8	2.0	2.2	W
	模式 6 的 Multi-Level AGC 功率	V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH		0.63	0.7	0.77	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH		0.81	0.9	0.99	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH		1.26	1.4	1.54	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH		1.62	1.8	1.98	W
	模式 7 的 Multi-Level AGC 功率	V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH		0.54	0.6	0.66	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH		0.72	0.8	0.88	W
		V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH		1.08	1.2	1.32	W
V <sub>DD</sub> =4.2V, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH		1.44	1.6	1.76	W		
PSRR	电源抑制比	V <sub>DD</sub> =4.2V, V <sub>p-p_sin</sub> =200mV	217Hz		-68	-58	dB
			1kHz		-68	-58	dB
SNR	信噪比	V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>o</sub> =1.75W, THD+N=1%, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, A <sub>v</sub> =8V/V			98.8		dB
		V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>o</sub> =2.05W, THD+N=1%, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH, A <sub>v</sub> =8V/V			98.2		dB
V <sub>n</sub>	输出噪声电压	A-weighting	V <sub>DD</sub> =4.2V, f=20Hz to 20kHz, input ac grounded, A <sub>v</sub> =8V/V		43		μVrms
			V <sub>DD</sub> =4.2V, f=20Hz to 20kHz, input ac grounded, A <sub>v</sub> =12V/V		48		μVrms
			V <sub>DD</sub> =4.2V, f=20Hz to 20kHz, input ac grounded, A <sub>v</sub> =16V/V		57		μVrms
THD+N	总谐波失真+噪声	V <sub>DD</sub> =3.6V, P <sub>o</sub> =1W, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, f=1kHz, Mode1			0.008		%
		V <sub>DD</sub> =3.6V, P <sub>o</sub> =1W, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH, f=1kHz, Mode10			0.009		%
P <sub>o</sub>	模式 10 的输出功率	THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =4.2V			2.15		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =4.2V			1.75		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =3.6V			1.6		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =3.6V			1.28		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =4.2V			2.52		W

参数		条件	最小	典型	最大	单位
P <sub>o</sub>	模式 10 的输出功率	THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =4.2V		2.05		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =3.6V		1.82		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =6Ω+33μH, V <sub>DD</sub> =3.6V		1.5		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =4.2V		2.8		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =4.2V		2.4		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =3.6V		2.02		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =4Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =3.6V		1.68		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =4.2V		2.63		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =4.2V		2.35		W
		THD+N=10%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =3.6V		1.85		W
		THD+N=1%, f=1kHz, R <sub>L</sub> =3Ω+15μH, V <sub>DD</sub> =3.6V		1.65		W
<b>Receiver(模式 8-9)</b>						
I <sub>q</sub>	静态电流	V <sub>DD</sub> =4.2V, 无输入, 空载		5	7.5	mA
η	效率	V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>o</sub> =0.8W, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, 模式 9		86		%
Fosc	调制频率	V <sub>DD</sub> =3.0V to 5.5V	600	800	1000	kHz
A <sub>v</sub>	放大倍数	外部输入电阻=3kΩ, 模式 8		1		V/V
		外部输入电阻=3kΩ, 模式 9		3		V/V
R <sub>ini</sub>	内部输入电阻	模式 8		106.6		kΩ
		模式 9		36.6		kΩ
F <sub>hin</sub>	输入高通截止频率	C <sub>in</sub> =33nF, 外部输入电阻=3kΩ, 模式 8		44		Hz
		C <sub>in</sub> =33nF, 外部输入电阻=3kΩ, 模式 9		122		Hz
V <sub>n</sub>	输出噪声电压	V <sub>DD</sub> =4.2V, f=20Hz to 20kHz, input ac grounded, A <sub>v</sub> =1V/V	A-weighting	19		μVrms
		V <sub>DD</sub> =4.2V, f=20Hz to 20kHz, input ac grounded, A <sub>v</sub> =3V/V		22		μVrms
THD+N	总谐波失真+噪声	V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>o</sub> =0.1W, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, f=1kHz, 模式 8		0.025		%
		V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>o</sub> =0.4W, R <sub>L</sub> =8Ω+33μH, f=1kHz, 模式 9		0.025		%
<b>一线脉冲控制</b>						
T <sub>H</sub>	SHDN 高电平持续时间	V <sub>DD</sub> =3.0V to 5.5V	0.75	2	10	μs
T <sub>L</sub>	SHDN 低电平持续时间	V <sub>DD</sub> =3.0V to 5.5V	0.75	2	10	μs
T <sub>LATCH</sub>	SHDN 状态锁存时间	V <sub>DD</sub> =3.0V to 5.5V	150		500	μs
T <sub>OFF</sub>	SHDN 关断延迟时间	V <sub>DD</sub> =3.0V to 5.5V	150		500	μs
<b>Multi-Level AGC <sup>(注 4)</sup></b>						
T <sub>ATF</sub>	快速启动时间	完成 10dB 压缩		1.5		ms
T <sub>ATS</sub>	慢速启动时间	完成 3.5dB 压缩		6		ms
T <sub>ATT</sub>	总启动时间	完成 13.5dB 压缩		7.5		ms
T <sub>RLT</sub>	总释放时间	完成 13.5dB 释放		280		ms
A <sub>MAX</sub>	最大衰减增益			-13.5		dB

注 4: 启动时间是指增益衰减 13.5dB 的时间, 释放时间是指增益恢复 13.5dB 的时间。



## 测试方法

AW87318 为数字输出方式，输出为方波信号，如图 6 所示，需要在两个输出各接一个低通滤波器将开关调制频率滤除，然后测量滤波器的差分输出即可得到模拟输出信号。

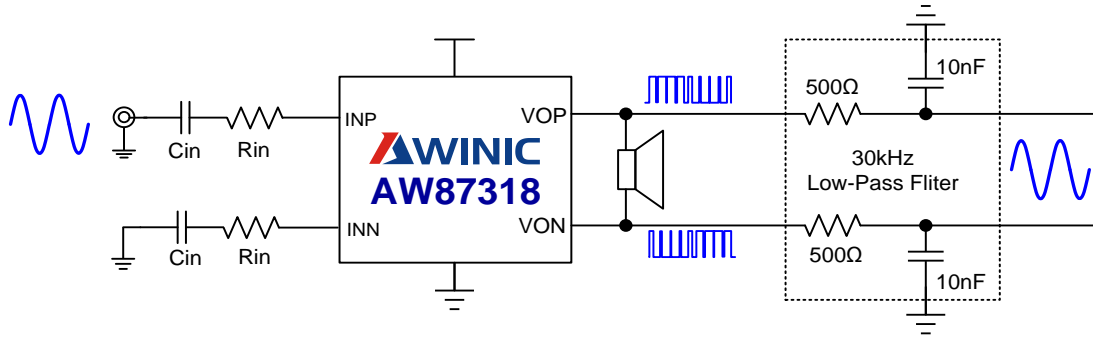


图 6 AW87318 测试电路图

低通滤波器推荐采用表 1 中的电阻、电容值。

滤波电阻	滤波电容	低通截止频率
500Ω	10nF	32kHz
1kΩ	4.7nF	34kHz

表1. AW87318 测试用滤波器推荐值

### 功率计算方法

根据上面的测试方法，在低通滤波器的输出端得到差分模拟信号，利用示波器测试差分模拟信号的有效值  $V_{o\_rms}$ ，如下图所示：

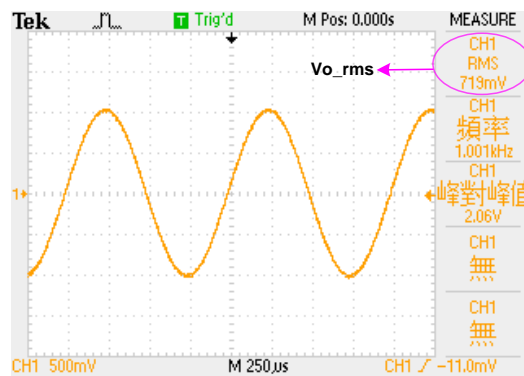
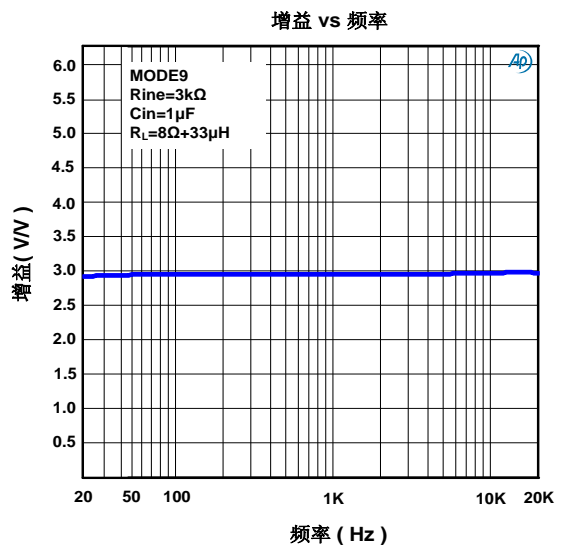
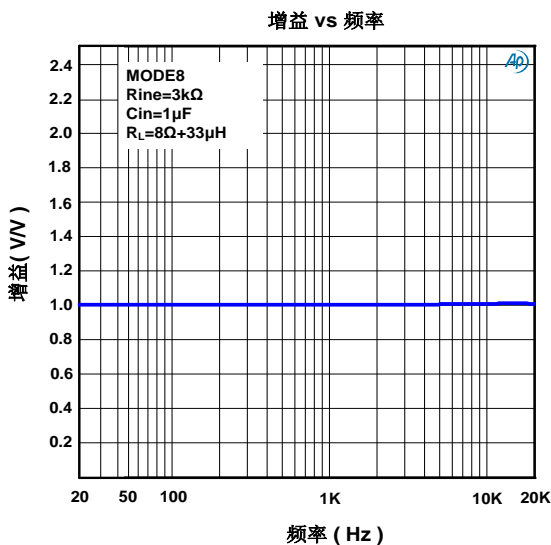
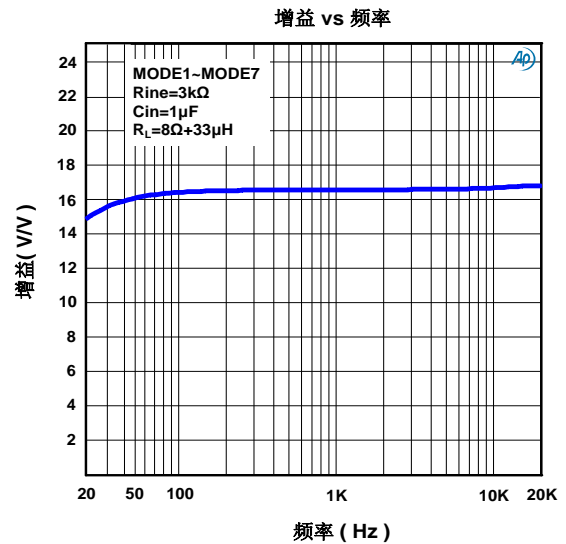
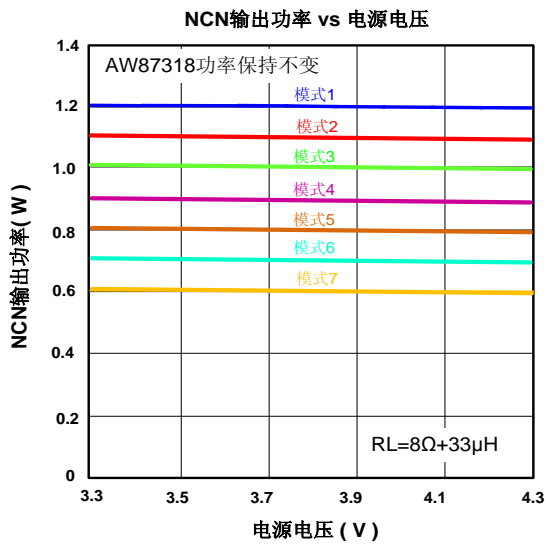
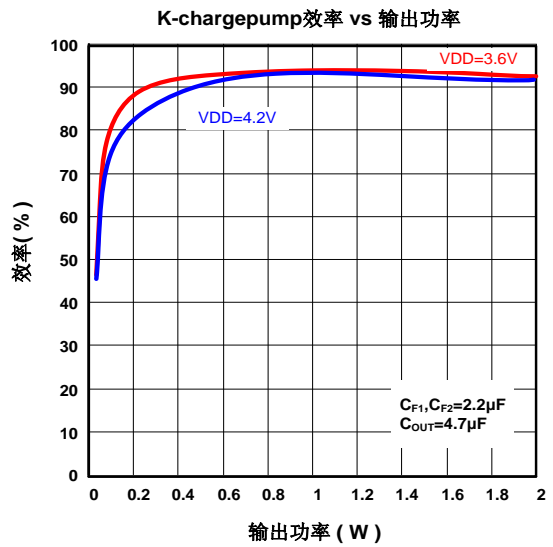
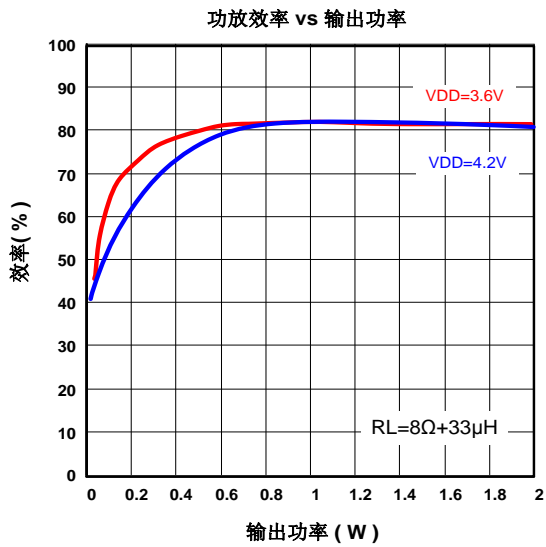


图 7 输出有效值示意图

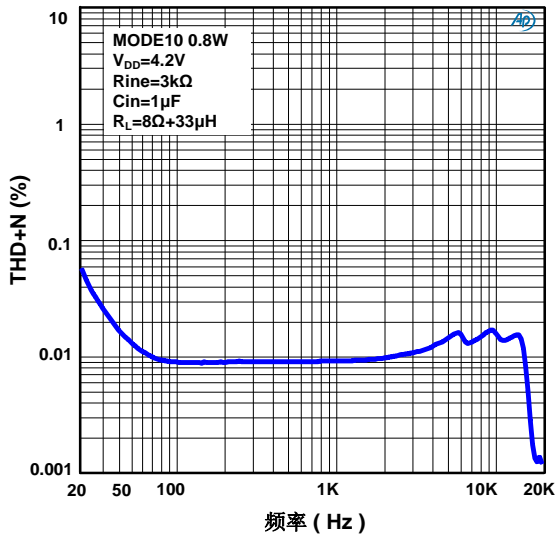
扬声器的功率计算如下：

$$P_L = \frac{(V_{o\_rms})^2}{R_L} \quad (R_L: \text{扬声器的负载阻抗})$$

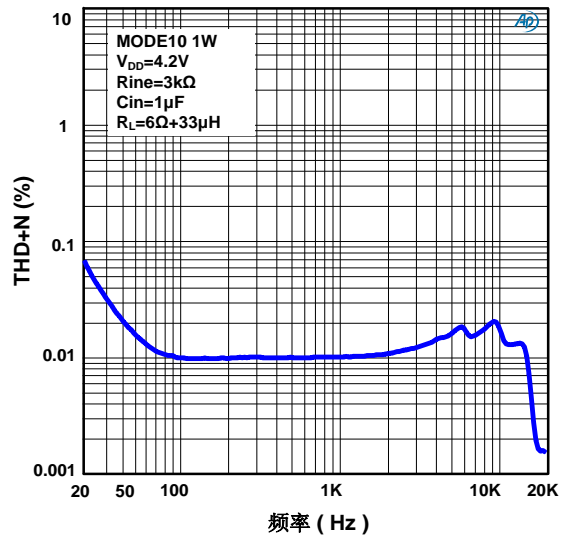
典型特性曲线



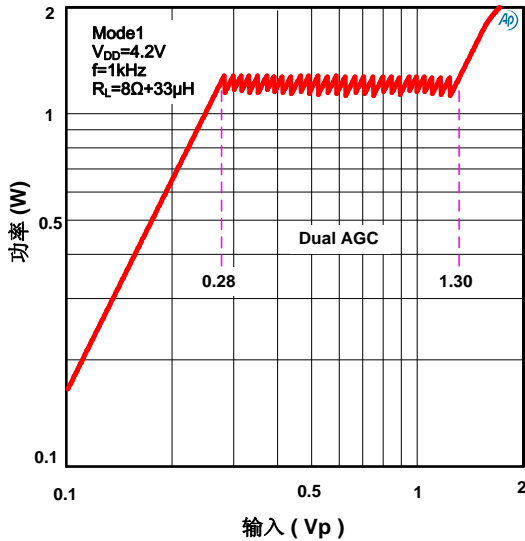
THD+N vs 频率



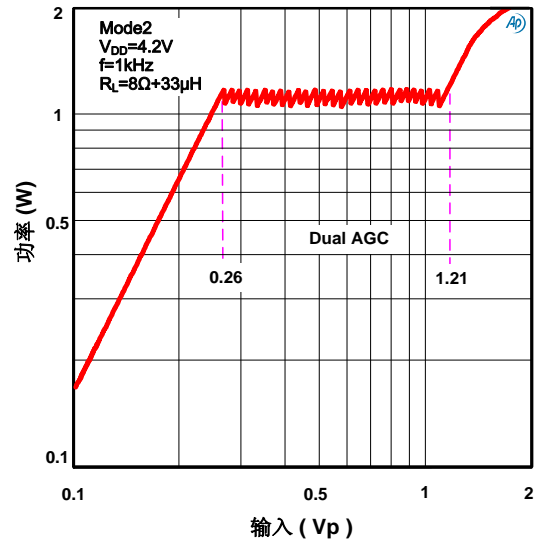
THD+N vs 频率



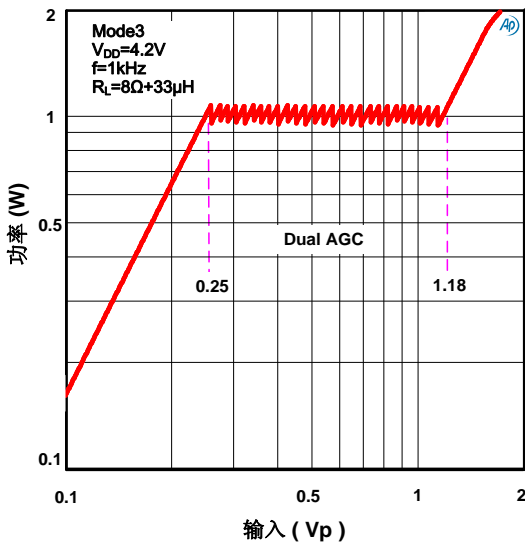
功率 vs 输入



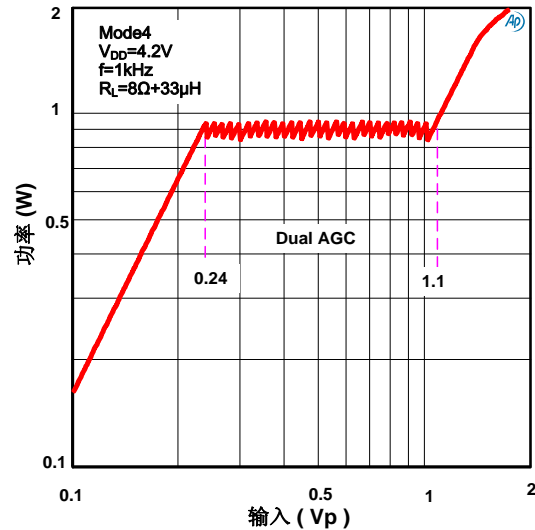
功率 vs 输入

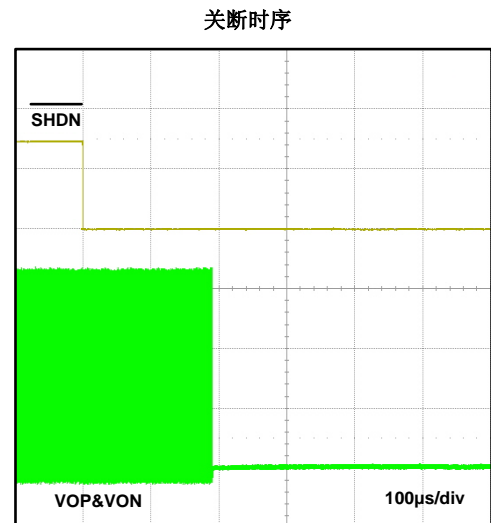
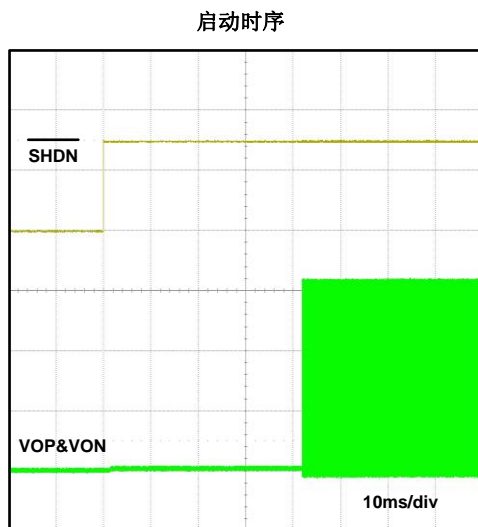
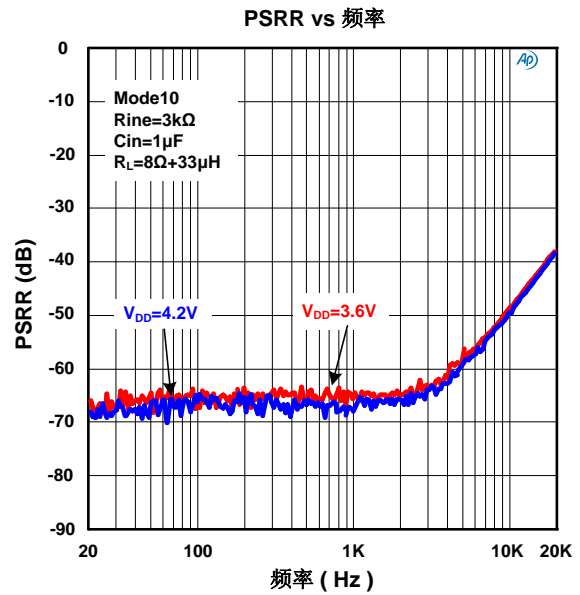
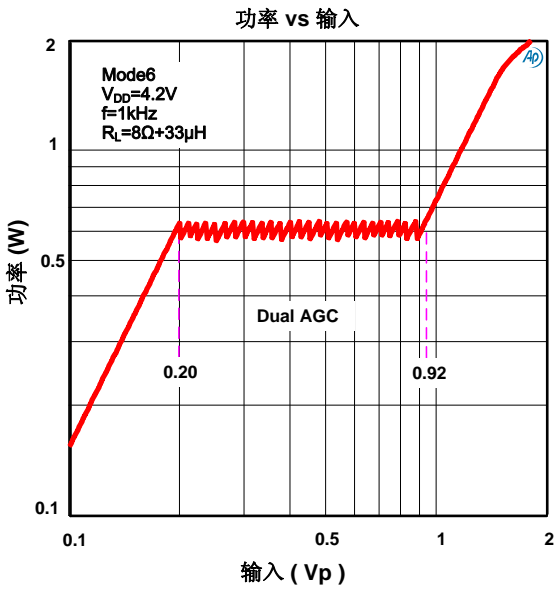
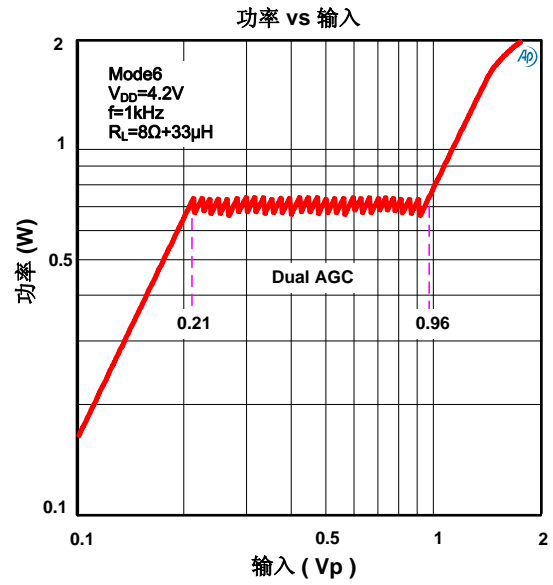
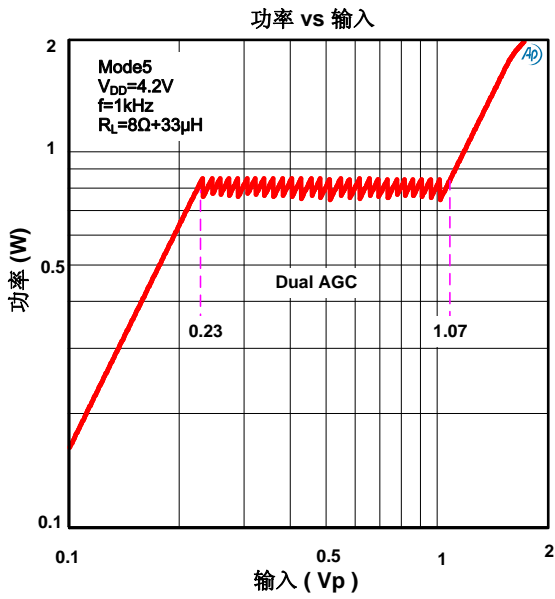


功率 vs 输入

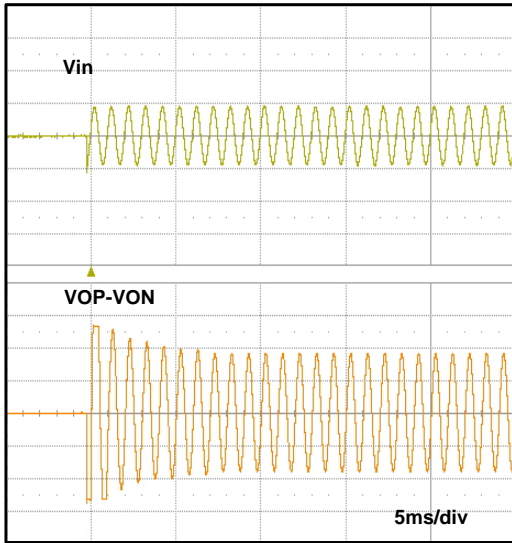


功率 vs 输入

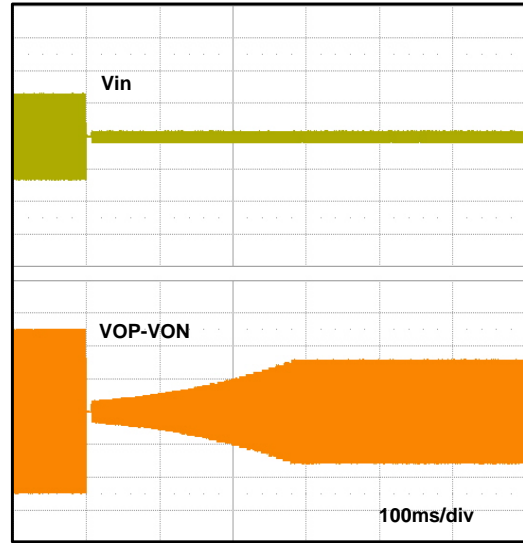




**MULTI-LEVEL-AGC**  
功能启动时序



**MULTI-LEVEL-AGC**  
功能释放时序



## 工作原理

AW87318 是专门针对消除智能机音乐杂音，提升整体音质而开发的高效率，低噪声，恒定大音量的升级版第八代 K 类音乐功放。AW87318 集成艾为专有的 Multi-Level AGC 算法，有效消除音乐播放中的杂音，同时提升音质音量。AW87318 采用效率高达 93% 的 K-Chargepump 电荷泵升压技术，使功放整体效率高达 83%；AW87318 的底噪低至  $43\mu\text{V}$ ，具有高达 98.8dB 的信噪比(SNR)，0.008% 的超低失真度和独特的 Multi-Level AGC 技术，带来高品质的音乐享受。

AW87318 有 0.6W~1.2W 七个细分喇叭保护功率等级，适合不同额定功率的喇叭，应用灵活，同时配合 Multi-Level AGC 算法，使音乐纯粹自然，悦耳动听。AW87318 输出功率在手机整个工作电压（3.3V~4.35V）内保持恒定，防止手机使用过程中，声音越来越小。

AW87318 支持 Speaker 和 Receiver 的二合一应用。在 Receiver 应用时，输出底噪低至 19uV，D 类工作模式，电源由 VBAT 直通提供。

AW87318 内置优异的 Pop-click 杂音抑制电路，有效避免了芯片在开启和关断操作时的 Pop-click 杂音。

AW87318 采用艾为专有的 TDD-Noise 抑制技术和 EMI 抑制技术，有效抑制 TDD-Noise 和 EMI 干扰的产生。

AW87318 内置过流保护、过热保护和短路保护功能，有效地保护芯片。AW87318 采用纤小的 0.4mm pitch 1.6mm×1.68mm CSP-14 封装。

## 恒定功率输出

在手机音频应用中，AGC 功能对提升音乐音量音质非常具有诱惑力，但是随着锂电池电压的下降，普通功放的输出功率会逐渐减小，使得音乐音量越来越小，难以在整个电池电压范围内提供高品质的音乐。AW87318 集成艾为专有的 Multi-Level AGC 技术，在整个锂电池电压 3.3V~4.35V 范围内，AGC 功率保持恒定，输出功率不会随着电池电压的降低而下降，在手机使用过程中，即使电池电压下降，AW87318 依然

可以提供高品质大音量的音乐享受。AW87318 共有 10 种工作模式，其中前七种工作模式带有 Multi-level AGC 功能，输出功率保持恒定，功率等级更加细化，分别为 1.2W，1.1W，1W，0.9W，0.8W，0.7W，0.6W，适合不同额定功率的喇叭，应用灵活。

## Multi-Level AGC 技术

在实际音频应用中，系统的输出功率往往会超过扬声器的额定功率，比如在 5V 供电的情况下，对 8Ω 的扬声器，最大不失真功率为 1.56W 左右，但是很多扬声器的额定功率在 0.5W 左右，如果不进行功率控制，过载的信号会对扬声器造成损坏，带有 NCN 功能(即 Single-level AGC)的音频功放可以有效的保护扬声器，随着输入信号的增大，输出功率随之增大，该 NCN 功能在输出功率超过设定的阈值功率后，自动降低功放内部的增益，将输出功率限制在设定的阈值功率处；但 NCN 功能有启动时间的设置，启动时间的设置是在听感与截顶杂音之间折衷，如果启动时间较长，音量会较大，但截顶失真也会随之增多；如果启动时间较短，截顶失真会随之减少，但音量也会降低。一般的音乐文件的峰值因子较大，范围在 40~60dB 左右，在播放音乐的时候，大的峰值信号输出超过了最大输出幅度，就会发生截顶失真，部分音乐会听到明显的杂音，因此需要 Multi-level AGC 技术对音频功放进行动态调整，在提升小音量音乐文件播放音量的同时，消除大音量音乐文件播放时所出现的杂音，提升音质。

AW87318 集成艾为专有的 Multi-Level AGC 算法，有效消除音乐播放中的杂音，使音乐纯净自然，极大的提升了音质音量。Single-level AGC 功能和带 Multi-level AGC 功能如下图 8 所示。

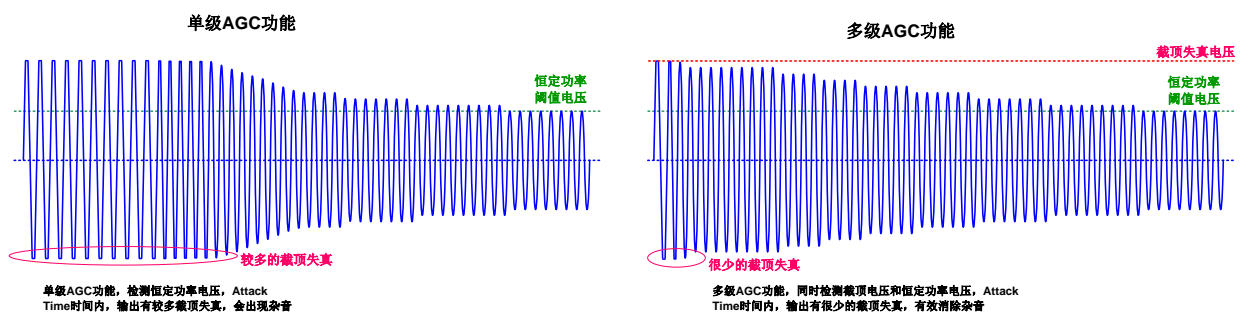


图 8 单级 AGC/多级 AGC 工作原理图

### 启动时间 (attack time)

启动时间是指 Multi-level AGC 功能从检测发现输出破音失真，到增益衰减-13.5dB 所需要的时间，包含快速启动时间和慢速启动时间。当发生输出破音失真时，Multi-level AGC 启动 Fast AGC 对信号快速压缩，增益衰减 10dB，所需时间为 1.5ms；当破音失真消除后，启动 Slow AGC 对信号缓慢压缩，增益衰减 3.5dB，所需时间为 6ms。AW87318 针对智能手机中出现音乐杂音的特点，采用艾为专有的 Multi-level AGC 技术，使输出具有很少的截顶失真，有效消除音乐播放中的杂音，同时保持音乐缓慢变化的韵律，最大限度的提升音量，有效保护喇叭。

### 释放时间 (release time)

释放时间是指 Multi-level AGC 功能从检测输出不再破音失真或超过恒定功率电压，到恢复为正常增益所需要的时间。AW87318 针对智能手机消除杂音，提升音质音量等要求，根据实际音乐播放效果，将释放时间设定为 280ms，既可以较好地抑制杂音，又会使音乐听起来纯净自然。

### K-Chargepump 电荷泵

AW87318 采用 K-chargepump 电荷泵升压技术，具有高效率和高驱动能力，工作频率 1.1MHz，内置软启动电路，限流控制环路和过压控制环路，保证电路稳定可靠工作。

#### 高效率

AW87318 采用的 K-chargepump 电荷泵架构，升压输出电压 PVDD 为输入电压 VDD 的 1.5 倍，理想效率可达 100%。K-chargepump 电荷泵的效率是输出功率和输入功率的比值，即

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} * 100\%$$

比如在一个理想的M倍压K-chargepump电荷泵中，输入电流I<sub>IN</sub>是输出电流I<sub>OUT</sub>的M倍，效率公式可以写为：

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} * 100\% = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{IN} * M * I_{OUT}} * 100\% = \frac{V_{OUT}}{M * V_{IN}} * 100\%$$

其中M是电荷泵的工作模式变量(1.5 倍),V<sub>OUT</sub>为电荷泵输出电压，V<sub>IN</sub>为电源电压，I<sub>OUT</sub>为负载电流。对于K-chargepump电荷泵，输出电压是输入电压的 1.5 倍，可以极大的提高电源效率，考虑到电荷泵内部开关的损耗和IC静态电流损耗，实际的效率也高达 93%。

#### 电荷泵结构

图 9 为电荷泵的基本原理图，AW87318 中使用的电荷泵包括 7 个开关，通过对 7 个开关的时序控制，使输出电压 PVDD 为输入电压 VDD 的 1.5 倍。

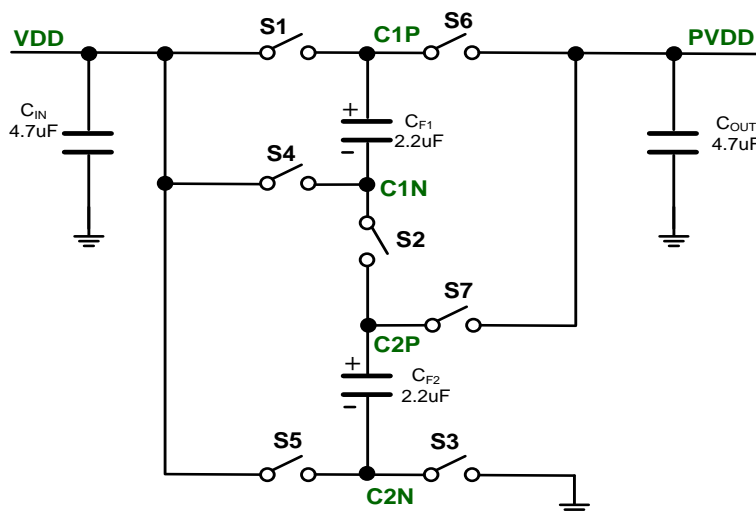


图 9 电荷泵原理图

电荷泵的工作过程有两个相位，在  $\Phi 1$  中，如图 10 所示：S1, S2 和 S3 闭合，VDD 对 Flying 电容  $C_{F1}$ ,  $C_{F2}$  充电。

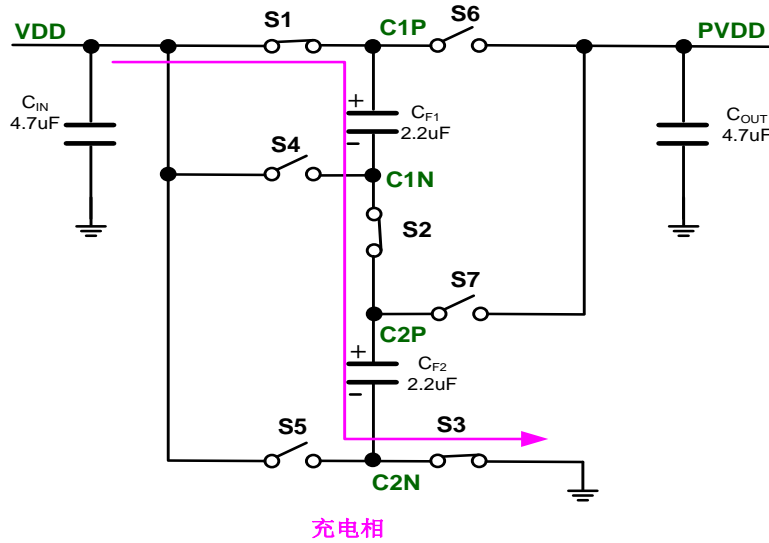


图 10  $\Phi 1$ : Flying 电容充电

在  $\Phi 2$  中，如图 11 所示：S1, S2 和 S3 断开，S4, S5, S6 和 S7 闭合，由于电容两端的电压不能突变，因此 Flying 电容  $C_{F1}$ ,  $C_{F2}$  电压叠加在 VDD 上，使 PVDD 升到了更高的电压。

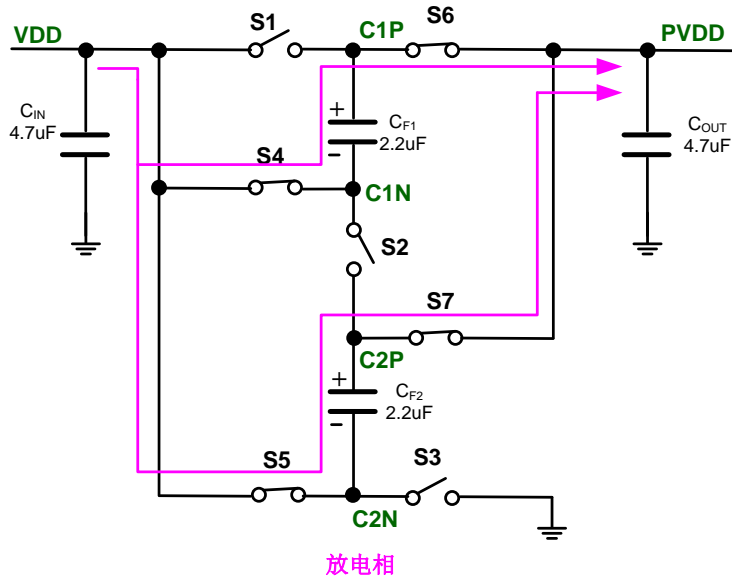


图 11  $\Phi 2$ : Flying 电容电荷转移到输出电容 COUT

### 软启动

为了限制 K-chargepump 电荷泵启动过程中电源的浪涌电流，电荷泵具有软启动功能。启动过程中电源电流限制在 300mA。软启动时间为 1.2ms。



### 限流控制

K-chargepump 电荷泵架构集成了限流控制环路，在正常工作中，当负载过重或者某种情况使电荷泵流过很大电流时，限流控制环路控制电荷泵的最大输出电流能力，电源限流在 2A；

### 过压保护(OVP)控制

K-chargepump 电荷泵架构的输出电压 PVDD 是输入电压 VDD 的 1.5 倍，为内部功放电路提供高压电压轨，允许功放在锂电池电压范围内提供更大的输出动态范围，从而实现大音量、高品质的 K 类音响功放播放效果。K-chargepump 集成了过压保护控制环路，在输入电压 VDD 大于 4V 时，输出电压 PVDD 不再是 VDD 的倍数，而是由过压控制环路使 PVDD 稳定在 6.05V，迟滞电压为 50mV 左右。

### Speaker & Receiver 二合一应用

AW87318 中的模式 8，模式 9 为 Receiver 模式，放大倍数可选，分别为 1V/V 和 3V/V，应用灵活。Receiver 模式共用 speaker 的信号通路，具有超低失真及很强的驱动能力，非常适合高清语音应用，而且无需额外外围元器件，更好的节省系统成本和 PCB 布板空间。

图 5 的典型应用情况下，输入电容  $C_{in}=33nF$ ，输入电阻  $R_{in}=3k\Omega$ ，speaker 应用模式下的放大倍数为 16.6V/V，输入高通截止频率为 502Hz；1V/V receiver 应用模式时，输出底噪为 19 $\mu$ V，输入高通截止频率为 44Hz，可在不改变任何硬件的情况下实现 speaker 和 receiver 的二合一应用。

### 抗干扰一线脉冲控制技术

一线脉冲控制技术是一种只需要单 GPIO 口就可以对芯片进行操作，完成多种功能的控制方法，在 GPIO 口紧缺和布线紧张的便携式系统中很受欢迎。

当控制信号的走线比较长，由于信号完整性或者射频干扰的问题，会产生窄小的毛刺信号，艾为的一线脉冲控制在控制管脚内部加入了 Deglitch 技术，可以有效消除毛刺信号的影响，如图 12 所示。

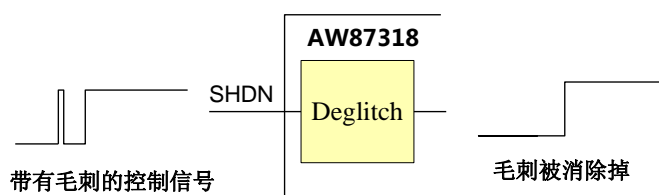


图 12 艾为 Deglitch 功能示意图

传统的一线脉冲控制在芯片启动后仍然接收控制端口的脉冲信号，因此当主控芯片（如手机 BB）在芯片工作期间误送脉冲时，就会发生状态错误的现象。AW87318 采用了一线脉冲状态锁存的技术，在主控芯片送入脉冲后，将状态锁存，不再接收误送的脉冲信号，如图 13 所示。

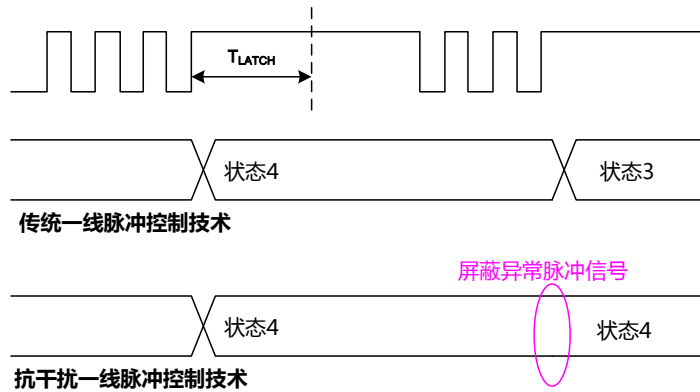


图 13 抗干扰一线脉冲功能示意图

一线脉冲控制方法

AW87318 通过检测 SHDN 管脚送入的一线脉冲信号上升沿数目来判断进入何种模式，如图 14 所示：SHDN 管脚直接拉高并保持高电平，只有一个上升沿，AW87318 进入模式 1；SHDN 管脚直接拉高、拉低、拉高并保持高电平，有两个上升沿，AW87318 进入模式 2.....依次类推，AW87318 有 10 种工作模式，最多可以送入 10 个上升沿，上升沿的数目不允许超过 10 个。

一线脉冲的高、低电平时间为 0.75μs 到 10μs 之间，建议采用 2μs 的高、低电平时间。

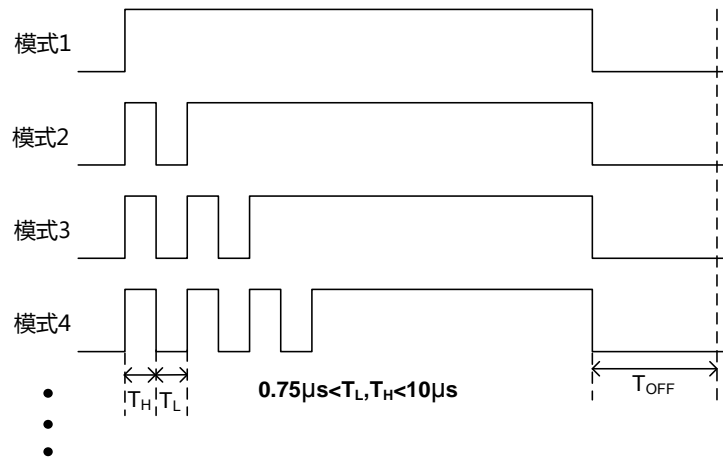


图 14 一线脉冲控制方法

需要在模式之间切换时，需要将 SHDN 先拉低，拉低时间（建议拉低时间为 1ms）超过 T<sub>OFF</sub> 后，芯片关断，内部寄存器复位，再送入需要的脉冲就可以了，如图 15 所示。

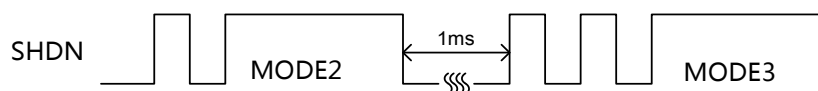


图 15 一线脉冲状态切换控制时序

## RNS(RF TDD Noise Suppression)

### TDD Noise 产生的原因

GSM 蜂窝电话采用 TDMA: Time Division Multiple Access(时分多址)时隙分享技术。时分多址把时间分割成周期性的帧，每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号，基站发向多个移动终端的信号也都按顺序安排在预定的时隙中传输。这其中每个 TDMA 帧含 8 个时隙，整个帧时长约为 4.615ms，每个时隙时长为 0.577ms。

GSM 制式的手机，RF 功率放大器每隔 4.615ms（217Hz）就会有一次讯号传输，讯号传输时会产生间歇的 Burst 电流和很强的电磁辐射。间歇的 Burst 电流会形成 217Hz 的电源波动；900MHz 和 1800MHz 的高频 RF 信号形成了 217Hz 的射频包络信号。217Hz 的电源波动会通过传导耦合到音频讯号通路中，217Hz 的射频包络信号会通过辐射耦合到音频讯号通路中，如果防护不好，就会产生可听到的 TDD Noise，其中包括了 217Hz 噪声和 217Hz 的谐波噪声信号。

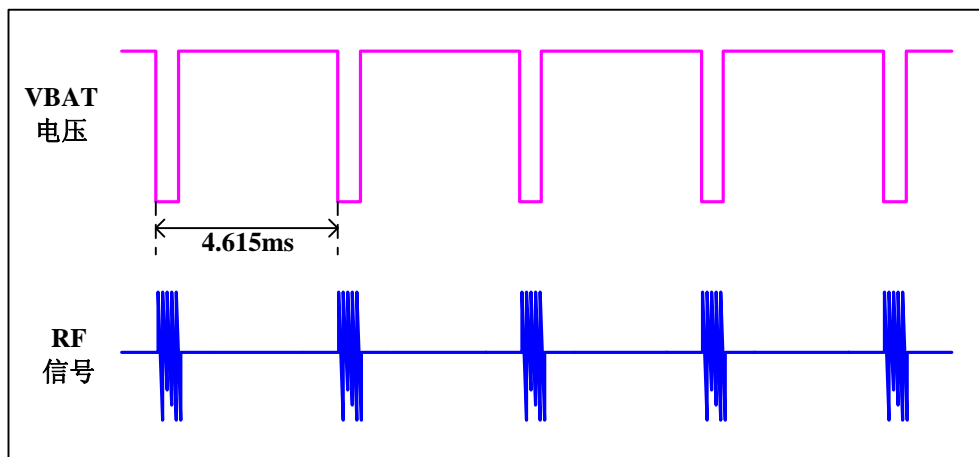


图 16 GSM 射频工作时电源电压和 RF 信号示意图

RNS 技术通过艾为特有的电路架构对传导和辐射的干扰进行了全方面的抑制。有效提高对 TDD Noise 的抑制能力

### 传导噪声的抑制

RF 功率放大器工作时，以 217Hz 的频率从电池中抽取电流，由于电池有一定的内阻，会在电源上引起 217Hz 的电源纹波，电源纹波会通过音频功率放大器耦合到喇叭上。对电源波动的抑制能力取决于音频功率放大器的 PSRR。

$$PSRR = 20 \log \left( \frac{v_{out\_ac}}{v_{dd\_ac}} \right)$$

全差分放大器由于输入、输出完全对称，理论上电源波动对两个输出的影响是完全一样的，差分输出完全不受电源波动的影响。实际情况中，由于工艺偏差等因素影响，放大器会有一定的失配，PSRR 一般

都优于-60dB，-60dB 表示输出相对于电源的波动可以衰减 1000 倍，比如 500mVp 的电源波动，差分输出为 0.5mV，基本可以满足应用需求。

但在实际应用中，PSRR 为-60dB 甚至-80dB 的功率放大器都可能会碰到传导的 TDD Noise 问题，这是为什么呢？这里我们还需要考虑音频功率放大器外围器件失配的影响。

对传统音频功率放大器，当输入电阻  $R_{in}$ 、输入电容  $C_{in}$  发生失配时，会极大地影响音频功率放大器的 PSRR 指标，在 24 倍放大倍数情况下，1%的输入电阻、电容失配会使 PSRR 弱化到-46dB 左右，10%的输入电阻、输入电容失配会使 PSRR 弱化到-28dB 左右，当电源波动较大时，就很容易产生可听到的 TDD Noise。

为了提升输入电阻、输入电容失配情况下音频功率放大器的 PSRR，AW87318 采用了特有的传导噪声抑制电路，使得输入电阻、输入电容偏差 10%甚至更大的情况下仍然保持较高的 PSRR 值，极大地抑制了传导噪声的产生。

### 辐射噪声的抑制

音频讯号模块的输入走线，输出走线，喇叭环路，甚至电源和地环路都可能会受到 RF 辐射干扰，较长的输入走线、输出走线类似于天线的作用，尤其容易受到 RF 辐射的影响。

在设计中可以采用合理的 PCB 布局来降低 RF 辐射的影响，如尽量缩短输入、输出走线长度；音频器件尽量远离 RF 天线并屏蔽；保持音频讯号通路上各器件地的完整性；在敏感结点增加到地的小电容旁路 RF 信号等。但是在实际应用中，PCB 布局很难完全考虑到 RF 辐射对音频讯号通路的影响，仍然会有一些 RF 能量会耦合到音频讯号通路中，形成可听的 TDD Noise。为此，AW87318 在芯片内部采用了特有的 RF 辐射抑制电路，在芯片内部建立屏蔽层，有效阻挡高频 RF 能量进入芯片中，保证功放输出给喇叭的驱动信号不会受到天线 RF 辐射的影响，从而避免了由于天线 RF 辐射引起的 TDD Noise。

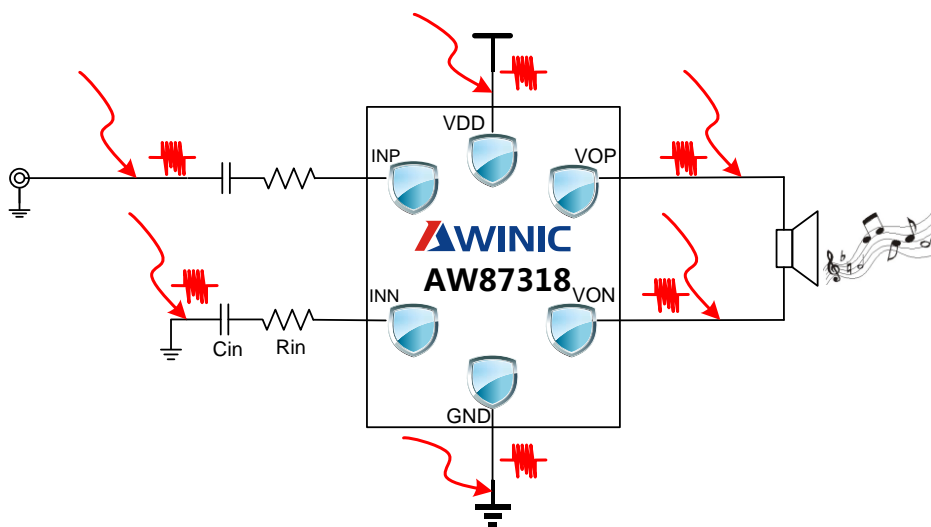


图 17 RF 辐射耦合示意图

## 无需滤波器的 D 类放大器

传统 D 类放大器在无输入信号的空闲状态，输出是反相的方波输出，反相的方波直接加在喇叭负载上，会在喇叭上形成很大的开关电流功耗，因此需要在功放输出增加 LC 滤波器来恢复模拟音频信号。LC 滤波器增加了成本和 PCB 布板面积，同时增加了功耗，降低了 THD+N 等性能。

AW87318 采用了无需滤波器的 D 类放大器架构，不需要输出的 LC 滤波器。在无输入信号的空闲状态，功放的两个输出（VOP、VON）为同相的方波，不会在喇叭负载上产生空闲开关电流。在输入端加了输入信号后，输出的占空比发生变化，VOP 的占空比变大的同时 VON 的占空比变小，输出的差分在喇叭上形成了输出的差分放大信号。

## EEE

AW87318 采用艾为拥有专利的 EEE 技术，有效控制功放数字输出时的边沿速度，在全带宽范围内极大地降低 EMI 干扰，完全满足 FCC CLASS B 规范要求。

## Pop-Click 抑制

Pop-Click 是发生在功放开启和关断瞬间的异常杂音，AW87318 采用艾为专有的 Pop-Click 抑制电路，有效抑制功放打开、关断时的瞬间噪声。

## Thermal AGC/过温保护

AW87318 采用拥有专利的 Thermal AGC 技术，可以根据芯片温度变化，自动调节系统放大倍数，减小芯片自身消耗的功耗，防止芯片在温度过高的情况下受到损伤。

AW87318 具有自动温度检测机制，当芯片温度超过预设的 Thermal AGC 启动温度阈值（150℃）时，芯片会启动自动增益控制电路以减小系统放大倍数，从而减小芯片自身所消耗的能耗，减缓或阻止芯片温度的继续上升。当芯片温度恢复到正常工作范围（低于 130℃）时，自动增益控制电路会将系统放大倍数恢复至原始状态。如果芯片工作在故障状况下，芯片温度过高，上升到预设的过热保护温度阈值（160℃）时，系统会启动过热保护，将芯片关断。当芯片温度恢复至正常工作范围（低于 120℃）时，AW87318 重新启动，恢复正常工作。

## 自动恢复的过流保护功能

AW87318 带有可自动恢复的输出过流保护功能，当过流发生的时候，AW87318 内部的保护电路将芯片关断，保证芯片不被损坏，当短路故障消除后，芯片自动恢复工作，无需重新启动。

## 应用信息

### 输入电阻 $R_{ine}$ (放大倍数设定)

AW87318 的输入端为差分放大器结构，可以采用单端输入接法和差分输入接法，两种接法的放大倍数设定是相同的。

AW87318 集成了一部分输入电阻，可以通过改变外置输入电阻的阻值对放大倍数进行调节，其中，内置输入电阻  $R_{ini}$  为  $6.6k\Omega$ 。以外置  $R_{ine}$  输入电阻= $3k\Omega$  为例，放大倍数的计算如下：

$$K \text{ 类模式: } A_v = \frac{159.5k\Omega}{R_{ine} + R_{ini}} = \frac{159.5k\Omega}{3k\Omega + 6.6k\Omega} = 16.6V/V$$

$$\text{Receiver 1V/V 模式: } A_v = \frac{110k\Omega}{R_{ine} + R_{ini}} = \frac{110k\Omega}{3k\Omega + 106.6k\Omega} = 1V/V$$

$$\text{Receiver 2V/V 模式: } A_v = \frac{110k\Omega}{R_{ine} + R_{ini}} = \frac{110k\Omega}{3k\Omega + 36.6k\Omega} = 2.8V/V$$

### 输入电容 $C_{in}$ (输入高通截止频率)

输入电容与输入电阻一起，形成了一个高通滤波器，用以滤除输入信号的直流分量。高通滤波器的-3dB点如下所示：

$$f_H(-3dB) = \frac{1}{2 * \pi * R_{intotal} * C_{in}} \text{ (Hz)}$$

应用中选用较小的  $C_{in}$  电容有助于滤除从输入端耦合进入的 217Hz 噪声，并且较小的电容有利于减小功放开启时的噼噍-咔哒声。两个输入电容之间良好的匹配有利于提升芯片整体性能及抑制噼噍-咔哒声，推荐使用容差 10% 或者更好的电容。

以典型应用中的输入电容、输入电阻值为例：，输入高通截止频率如下所示：

$$f_H(-3dB) = \frac{1}{2 * \pi * R_{intotal} * C_{in}} \text{ (Hz)} = \frac{1}{2 * \pi * 9.6k\Omega * 33nF} \text{ (Hz)} = 502\text{Hz}$$

Receiver 模式(Gain=1)应用时，输入高通截止频率如下所示：

$$f_H(-3dB) = \frac{1}{2 * \pi * R_{intotal} * C_{in}} \text{ (Hz)} = \frac{1}{2 * \pi * 109.6k\Omega * 33nF} \text{ (Hz)} = 44\text{Hz}$$

### 输入差分滤波电容 $C_d$ (输入低通截止频率)

输入差分滤波电容与输入电阻一起，形成了一个低通滤波器，可以用于衰减输入信号的高频分量，当扬声器播放音乐声音发尖时，可以适当衰减一部分高频输入信号，使音乐信号柔和、舒适。低通滤波器的-3dB点如下所示：

$$f_L(-3\text{dB}) = \frac{1}{2 * \pi * (R_{ini} // R_{ine}) * 2 * C_d} \text{ (Hz)}$$

以输入电阻  $R_{ine}=3\text{k}\Omega$ ，差分电容  $220\text{pF}$  为例，输入低通截止频率如下所示：

$$f_L(-3\text{dB}) = \frac{1}{2 * \pi * (R_{ini} // R_{ine}) * 2 * C_d} \text{ (Hz)} = \frac{1}{2 * \pi * 2.06\text{k}\Omega * 2 * 220\text{pF}} \text{ (Hz)} = 175.7\text{kHz}$$

### 电源退耦电容 ( $C_S$ )

良好的退耦电容可以提高功放的效率和最佳的性能，同时为得到良好的高频瞬态性能，希望电容的 ESR 值要尽量小。AW87318 的应用中，有两个 VDD 管脚，分别是 A3 和 B3，推荐使用低 ESR (equivalent-series-resistance) 的 X7R 或者 X5R 陶瓷电容，一般使用  $4.7\mu\text{F}$  的陶瓷电容将  $V_{DD}$  旁路到地，去耦电容在布局上应尽可能的靠近芯片的  $V_{DD}$  放置。如果希望更好地滤除低频噪声，则需要根据具体应用添加一个  $10\mu\text{F}$  或更大的去耦电容。同时在电源管脚上放置一个  $33\text{pF}\sim 0.1\mu\text{F}$  的陶瓷电容，用以滤除电源上的高频干扰，这个电容要尽量紧靠 A3, B3 管脚放置。

### 电荷泵 Flying 电容 ( $C_F$ )

Flying 电容用于在电源和电荷泵负载之间传递能量，Flying 电容的值直接影响电荷泵的负载调整率和输出驱动能力。Flying 电容太小，会影响电荷泵的负载调整率和输出驱动能力，从而影响功放的输出功率，Flying 电容越大，负载调整能力越强，驱动能力也越强。推荐使用  $2.2\mu\text{F}$ ，低 ESR 的 X7R、X5R 陶瓷电容，需要选用 10V 耐压的电容。

### 电荷泵输出电容 ( $C_{OUT}$ )

电荷泵的输出电容容值和 ESR 直接影响电荷泵输出电压的纹波大小，从而影响功放的性能。推荐使用  $4.7\mu\text{F}$ ，低 ESR 的 X7R、X5R 陶瓷电容，需要选用 10V 耐压的电容。

### 输出磁珠、电容

AW87318 在 K 类模式下，采用了 EEE 技术，在没有磁珠、电容的情况下，仍可满足 FCC CLASS B 规范要求。在输出线过长或者器件布局靠近 EMI 敏感设备时，建议使用磁珠、电容，磁珠、电容紧靠芯片输出管脚放置。

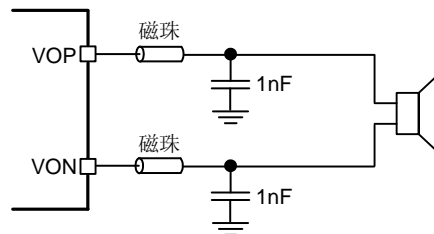
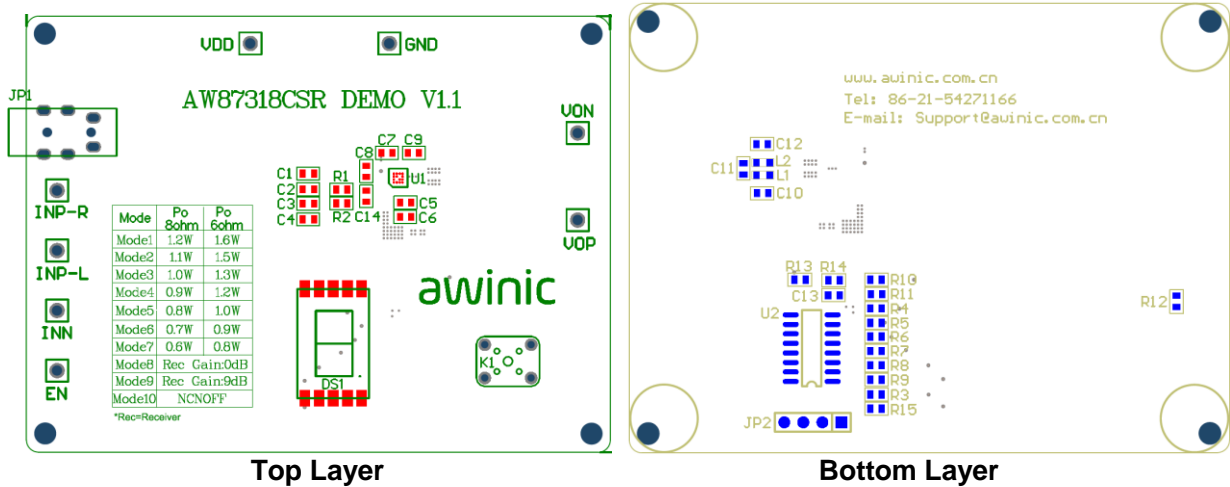


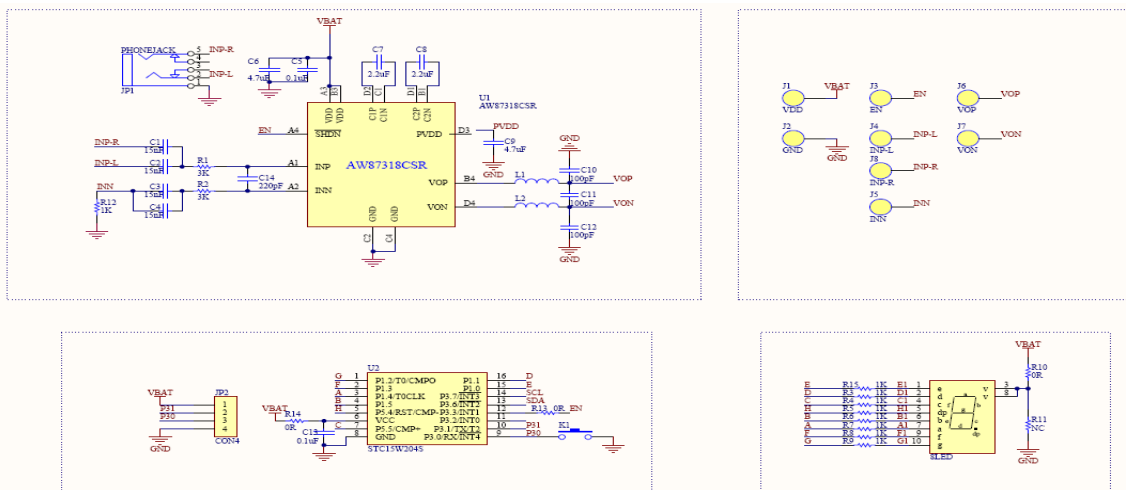
图 18 典型的输出磁珠、电容应用图

在 K 类模式下，输出为方波信号，该方波信号在输出电容上会形成开关电流，增加静态功耗，因此输出电容不宜太大，推荐使用  $1\text{nF}$  的陶瓷电容。

## DEMO PCB 位图



## DEMO PCB 原理图



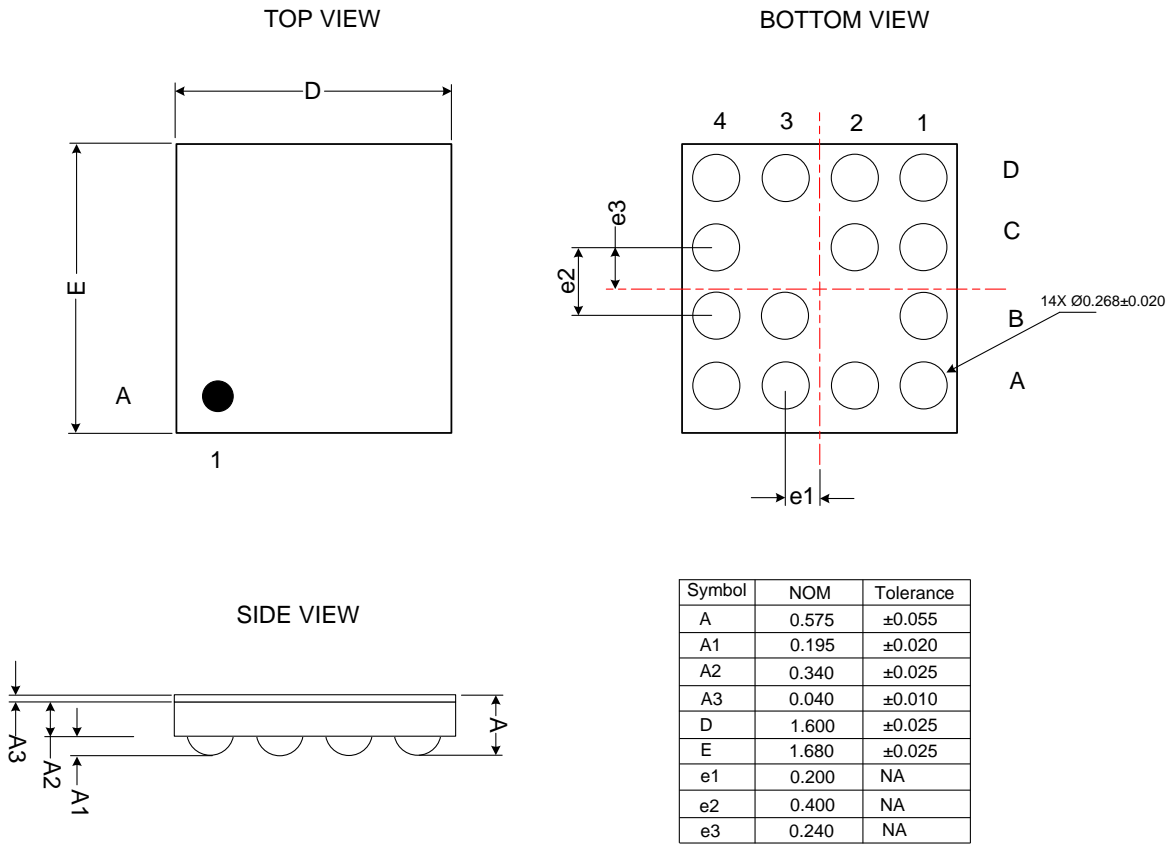
## PCB 布图及器件布局考虑

为了充分发挥 AW87318 的性能，PCB 的布局布线必须要仔细考虑，设计过程应该遵循以下原则：

- 1、尽量单独走一条短而粗电源线给 AW87318，推荐铜线宽度大于 0.75mm。去耦电容尽量靠近电源引脚放置。
- 2、Flying 电容  $C_{F1}$ ， $C_{F2}$  尽量靠近 AW87318 的 C1N，C1P 和 C2N，C2P 引脚放置，输出电容  $C_{OUT}$  靠近 PVDD 引脚放置，且电容到芯片引脚的连线尽量短而粗。
- 3、AW87318 的输入电容和输入电阻要尽量靠近芯片的 INN 和 INP 引脚放置，且输入线要平行走线抑制噪声耦合。
- 4、磁珠和电容靠近芯片的 VON 和 VOP 引脚放置，芯片到喇叭的输出线要尽量短而粗，推荐的铜线宽度大于 0.5mm。



封装描述



Unit: mm

## 版本信息

版本	日期	更新记录
V1.0	2015-10-16	AW87318CSR 芯片手册 V1.0

声明:上海艾为电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。  
上海艾为电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>AWINIC\(艾为\)](#)